

УДК 537.226; 548.4
 © 1990

ИЗГИБНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ДИСЛОКАЦИИ В СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКЕ

В. В. Дежин, В. Н. Нечаев, А. М. Роцункин

Исследованы изгибные колебания дислокации в сегнетоэлектрическом кристалле. Показано, что спектр колебаний состоит из двух ветвей — «квазиакустической» ($\omega \rightarrow 0$ при $q \rightarrow 0$, где ω и q — соответственно частота и волновой вектор изгибной волны) и «квазиоптической» ($\omega \neq 0$ при $q=0$). Вычислена обобщенная восприимчивость дислокации. Показано, что рассеяние энергии при колебаниях поляризации кристалла, сопутствующих колебаниям дислокации, вносит существенный вклад в затухание дислокационных колебаний.

Изгибные колебания дислокации в несегнетоэлектрических кристаллах рассматривались в работе [1], где был определен спектр собственных частот дислокации и исследовано рассеяние фононов на дислокациях. В сегнетоэлектриках в отличие от [1] колебания дислокации обязательно сопровождаются колебаниями электрических полей и поляризации, которые вызываются через посредство линейной или квадратичной стрикционной связи переменными упругими полями. В результате перенормируются эффективная масса дислокации и ее эффективная жесткость, появляется дополнительный вклад в затухание дислокационных колебаний вследствие рассеяния энергии при колебаниях поляризации. Возможно также образование локальных поляризационных мод, связанных с дислокацией. Исследование этих особенностей изгибных колебаний дислокации в сегнетоэлектрике — цель настоящей работы.

1. Вывод системы уравнений, описывающей колебания дислокации в сегнетоэлектрике

Исходную систему уравнений, описывающую динамику сегнетоэлектрического кристалла, состоящую из динамического уравнения теории упругости

$$\rho \frac{\partial v_i}{\partial t} + \frac{\partial \sigma_{ik}}{\partial x_k} = 0, \quad (1)$$

динамического уравнения для параметра порядка — вектора поляризации \mathbf{P} [2]

$$m \frac{d^2 \mathcal{P}_i}{dt^2} + h \frac{d \mathcal{P}_i}{dt} - \delta \Delta \mathcal{P}_i - \alpha \mathcal{P}_i + \beta \mathcal{P}_i^3 - g_{lmk} \sigma_{lm} \mathcal{P}_k = E_i \quad (2)$$

и уравнений электростатики

$$\text{div } \mathbf{D} = \text{div} (\mathbf{E} + 4\pi \mathcal{P}) = 0, \quad \text{rot } \mathbf{E} = 0, \quad (3)$$

для данной задачи удобно переписать, формулируя упругую задачу в напряжениях. В выражениях (1)—(3) использованы обозначения: ρ — плотность вещества кристалла, v_i — скорость элементов кристалла, σ_{ik} — тензор напряжений, h и m — коэффициент затухания и массовый коэффициент для колебаний поляризации соответственно, \mathbf{E} — вектор

напряженности электрического поля, δ — корреляционная постоянная, α и β — коэффициенты в разложении Ландау свободной энергии, g_{iklm} — тензор электрострикционных коэффициентов.

Для этого подставим в условие совместности деформаций Сен-Венана

$$e_{ikl}e_{jmn}U_{ln, km} = 0$$

(e_{ikl} — символ Леви-Чивитта) выражение для тензора полной деформации

$$U_{ln} = s_{lnkm}\sigma_{km} + \frac{1}{2}g_{lnkm}\mathcal{P}_k\mathcal{P}_m$$

где s_{lnkm} — тензор упругих податливостей, и учтем соотношение (1). В результате, предполагая изотропность упругих и электрострикционных свойств ($g_{lnkm}\mathcal{P}_k\mathcal{P}_m = g_1\delta_{ln}\mathcal{P}^2 + g_2\mathcal{P}_l\mathcal{P}_n$), получим обобщение динамического уравнения Бельтрами на случай сегнетоэлектрического кристалла

$$\begin{aligned} & \frac{1}{c_i^2} \frac{\partial^2 \sigma_{ij}}{\partial t^2} - \frac{1}{2(1+\nu)} \frac{1}{c_i^2} \delta_{ij} \frac{\partial^2 \sigma_{ll}}{\partial t^2} - \Delta \sigma_{ij} - \\ & - \frac{1}{1+\nu} \left(\frac{\partial^2 \sigma_{ll}}{\partial x_i \partial x_j} - \delta_{ij} \Delta \sigma_{ll} \right) + \rho g_2 \frac{\partial^2}{\partial t^2} (\mathcal{P}_i \mathcal{P}_j) - \frac{1}{2} \rho (g_1 + g_2) \delta_{ij} \Delta \mathcal{P}^2 \times \\ & \times \frac{\partial}{\partial t} (\mathcal{P}^2) + \mu (g_1 + g_2) \delta_{ij} \Delta (\mathcal{P}^2) - \mu (g_1 + g_2) \frac{\partial^2 (\mathcal{P}^2)}{\partial x_i \partial x_j} + \mu g_2 \frac{\partial^2 (\mathcal{P}_j \mathcal{P}_i)}{\partial x_i \partial x_l} + \\ & + \mu g_2 \frac{\partial^2 (\mathcal{P}_i \mathcal{P}_j)}{\partial x_j \partial x_l} - \mu g_2 \Delta (\mathcal{P}_i \mathcal{P}_j) - \mu g_2 \delta_{ij} \frac{\partial^2 (\mathcal{P}_l \mathcal{P}_k)}{\partial x_l \partial x_k} = 0, \end{aligned} \quad (4)$$

где $c_i = \sqrt{\mu/\rho}$ — скорость поперечного звука, μ — модуль сдвига, ν — коэффициент Пуассона.

При наличии в кристалле дислокаций появляется дополнительная несовместность деформаций, связанная с ними. Производя учет ее, согласно [3], и линеаризуя выражение (4) по отклонению поляризации $\mathcal{P}_1 = \mathcal{P} - \mathcal{P}_0$ от равновесного значения $\mathcal{P}_0 = \sqrt{2\alpha/\beta}$ в однородном кристалле, будем иметь

$$\begin{aligned} & \frac{1}{c_i^2} \frac{\partial^2 \sigma_{ij}}{\partial t^2} - \frac{1}{2(1+\nu)} \frac{1}{c_i^2} \delta_{ij} \frac{\partial^2 \sigma_{ll}}{\partial t^2} - \Delta \sigma_{ij} - \frac{1}{1+\nu} \left(\frac{\partial^2 \sigma_{ll}}{\partial x_i \partial x_j} - \delta_{ij} \Delta \sigma_{ll} \right) - \\ & - 2\mu (g_1 + g_2) \delta_{ij} \left[\frac{1}{2c_i^2} \frac{\partial^2 (\mathcal{P}_0 \cdot \mathcal{P}_1)}{\partial t^2} - \Delta (\mathcal{P}_0 \cdot \mathcal{P}_1) \right] + \\ & + \mu g_2 \left[\frac{1}{c_i^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} (\mathcal{P}_{0i} \mathcal{P}_{1j} + \mathcal{P}_{0j} \mathcal{P}_{1i}) - \Delta (\mathcal{P}_{0i} \mathcal{P}_{1j} + \mathcal{P}_{0j} \mathcal{P}_{1i}) \right] - \\ & - 2\mu (g_1 + g_2) \frac{\partial^2 (\mathcal{P}_0 \cdot \mathcal{P}_1)}{\partial x_i \partial x_j} + \mu g_2 \left(\mathcal{P}_{0i} \frac{\partial \operatorname{div} \mathcal{P}_1}{\partial x_j} + \mathcal{P}_{0j} \frac{\partial \operatorname{div} \mathcal{P}_1}{\partial x_i} \right) + \\ & + \mu g_2 \mathbf{P} \cdot \nabla \left(\frac{\partial \mathcal{P}_{1i}}{\partial x_j} + \frac{\partial \mathcal{P}_{1j}}{\partial x_i} - 2\delta_{ij} \operatorname{div} \mathcal{P}_1 \right) = \\ & = \rho \frac{\partial}{\partial t} (j_{ij} + j_{ji} - \delta_{ij} j_{ll}) - 2\mu \eta_{ij}. \end{aligned} \quad (5)$$

Здесь j_{ij} — тензор плотности потока дислокаций, в случае одиночной дислокации он имеет вид [4]

$$j_{ik} = -n_i b_k V \delta(\xi), \quad (6)$$

где \mathbf{n} — единичный вектор нормали к плоскости скольжения дислокации, \mathbf{b} — вектор Бюргера дислокации, V — проекция вектора скорости линии дислокации в данной ее точке на направление нормали к ней в плоскости скольжения, ξ — двумерный радиус-вектор, отсчитываемый от оси дислокации в плоскости, перпендикулярной единичному вектору касательной к линии дислокации в данной точке τ ,

$$\eta_{ij} = e_{jkn} \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\tau_i b_n - \frac{1}{2} \tau \cdot b \delta_{in} \right) \delta(\xi) \quad (7)$$

— тензор несовместности деформаций [5].

Полученную систему уравнений (2), (3), (5) необходимо дополнить уравнением движения самой дислокации

$$f_i(\xi) = e_{ikl} \tau_l \mathbf{e}_{im}(\xi) b_m = 0, \quad (8)$$

представляющем собой условие равенства нулю силы Пича—Келера в любой момент времени в любой точке дислокации. Поскольку движение дислокации происходит в плоскости скольжения, то в дальнейшем будем работать с проекцией этой силы f_i на плоскость скольжения

$$f_{\perp} = \mathbf{f} \cdot \mathbf{x} = n_i \mathbf{e}_{im} b_m, \quad (9)$$

где \mathbf{x} — единичный вектор нормали к линии дислокации в плоскости скольжения.

Система уравнений (2), (3), (5) с граничным условием (8) представляет собой полную систему уравнений, описывающую колебания сегнетоэлектрического кристалла с дислокацией. Умножив (5) на $n_i b_j$, получим уравнение непосредственно для величины f_{\perp} , совпадающей на линии дислокации с проекцией силы Пича—Келера,

$$\begin{aligned} & \frac{1}{c_l^2} \frac{\partial^2 f_{\perp}}{\partial t^2} - \Delta f_{\perp} + \frac{3}{1+\nu} (\mathbf{n} \cdot \nabla) (\mathbf{b} \cdot \nabla) p + \\ & + \mu g_2 \left\{ \frac{1}{c_l^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} [(\mathcal{P}_0 \cdot \mathbf{n}) (\mathcal{P}_1 \cdot \mathbf{b}) + (\mathcal{P}_0 \cdot \mathbf{b}) (\mathcal{P}_1 \cdot \mathbf{n})] - \right. \\ & \left. - \Delta [(\mathcal{P}_0 \cdot \mathbf{n}) (\mathcal{P}_1 \cdot \mathbf{b}) + (\mathcal{P}_0 \cdot \mathbf{b}) (\mathcal{P}_1 \cdot \mathbf{n})] \right\} - 2\mu (g_1 + g_2) (\mathbf{n} \cdot \nabla) (\mathbf{b} \cdot \nabla) (\mathcal{P}_0 \cdot \mathcal{P}_1) + \\ & + \mu g_2 \{ (\mathcal{P}_0 \cdot \mathbf{n}) (\mathbf{b} \cdot \nabla) \operatorname{div} \mathcal{P}_1 + (\mathcal{P}_0 \cdot \mathbf{b}) (\mathbf{n} \cdot \nabla) \operatorname{div} \mathcal{P}_1 \} + \\ & + \mu g_2 (\mathcal{P}_0 \cdot \nabla) \{ (\mathbf{b} \cdot \nabla) (\mathcal{P}_1 \cdot \mathbf{n}) + (\mathbf{n} \cdot \nabla) (\mathcal{P}_1 \cdot \mathbf{b}) \} = \\ & = -\rho b^2 \frac{\partial}{\partial t} (V \delta(\xi)) - 2\mu n_i \eta_{ij} b_j. \end{aligned} \quad (10)$$

Здесь использовано обозначение $p = -\sigma_{ii}/3$. Уравнение для величины p — гидростатического давления, — входящей в (10), получается в результате свертки выражения (5)

$$\begin{aligned} & \frac{1}{c_l^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} - \Delta p - \frac{4}{3} \mu (g_1 + g_2) \frac{1+\nu}{1-\nu} \left[\frac{3}{4c_l^2} \frac{\partial^2 (\mathcal{P}_0 \cdot \mathcal{P}_1)}{\partial t^2} - \Delta (\mathcal{P}_0 \cdot \mathcal{P}_1) \right] + \\ & + \frac{2}{3} \mu g_2 \frac{1+\nu}{1-\nu} \left[\frac{1}{c_l^2} \frac{\partial^2 (\mathcal{P}_0 \cdot \mathcal{P}_1)}{\partial t^2} - \Delta (\mathcal{P}_0 \cdot \mathcal{P}_1) \right] - \\ & - \frac{2}{3} \mu g_2 \frac{1+\nu}{1-\nu} (\mathcal{P}_0 \cdot \nabla) \operatorname{div} \mathcal{P}_1 = -\frac{2}{3} \mu \frac{1+\nu}{1-\nu} \eta_{ii}, \end{aligned} \quad (11)$$

где c_l — скорость продольного звука.

Дальнейшее рассмотрение во избежание громоздких выкладок произведем для конкретного случая краевой дислокации в одноосном сегнетоэлектрике.

2. Обобщенная восприимчивость и собственные частоты колебаний краевой дислокации в сегнетоэлектрике

Пусть сегнетоактивная ось совпадает с координатной осью OZ : $\mathcal{P} = (0, 0, \mathcal{P})$. Будем предполагать, что вдоль той же оси OZ расположено равновесное положение линии краевой дислокации: $\tau_0 = (0, 0, -1)$, вектор

Бюргера которой \mathbf{b} направлен по оси OX : $\mathbf{b} = (b, 0, 0)$. Ограничимся в дальнейшем рассмотрением случая малых колебаний дислокации.

Тогда, учитывая, что в линейном по смещению дислокации $u = u(z)$ приближении

$$\bar{\varepsilon} = (-du/dz, 0, -1), \quad \delta(\bar{\varepsilon}) = \delta(x)\delta(y) - \delta(y)\delta'(x)u(z),$$

уравнения (10), (11) приводим к виду

$$\begin{aligned} \frac{1}{c_T^2} \frac{\partial^2 f_1}{\partial t^2} - \Delta f_1 + \frac{3b}{1+\nu} \frac{\partial^2 p}{\partial x \partial y} - 2\mu(g_1 + g_2) \mathcal{F}_0 b \frac{\partial^2 \mathcal{F}_1}{\partial x \partial y} = \\ = -\mu b^2 \left(\frac{1}{c_T^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) \delta(x)\delta(y), \end{aligned} \quad (12)$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{c_T^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} - \Delta p - \frac{4}{3}\mu(2g_1 + g_2) \mathcal{F}_0 \frac{1+\nu}{1-\nu} \left[\frac{3g_1 + g_2}{2(2g_1 + g_2)} \frac{1}{c_T^2} \frac{\partial^2 \mathcal{F}_1}{\partial t^2} - \Delta \mathcal{F}_1 \right] - \\ - \frac{2}{3}\mu g_2 \frac{1+\nu}{1-\nu} \mathcal{F}_0 \frac{\partial^2 \mathcal{F}_1}{\partial z^2} = -\frac{2}{3}\mu \frac{1+\nu}{1-\nu} b [\delta(x)\delta'(y) - u\delta'(x)\delta'(y)]. \end{aligned} \quad (13)$$

Через электрострикционную связь (см. (2)) поляризация оказывается в нашем случае связанной как с гидростатическим давлением p , так и с компонентой σ_{zz} тензора напряжений. Уравнение для σ_{zz} очевидным образом следует из (5):

$$\begin{aligned} \frac{1}{c_T^2} \frac{\partial^2 \sigma_{zz}}{\partial t^2} - \Delta \sigma_{zz} + \frac{3}{1+\nu} \left[\frac{1}{2c_T^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} - \Delta p \right] - 2\mu g_1 \mathcal{F}_0 \left[\frac{g_1 - g_2}{2g_1 c_T^2} \frac{\partial^2 \mathcal{F}_1}{\partial t^2} - \Delta \mathcal{F}_1 \right] = \\ = -2\mu b [\delta(x)\delta'(y) - u\delta'(x)\delta'(y)], \end{aligned} \quad (14)$$

где $\Delta_{\perp} = \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2$. Систему уравнений (2), (3), (12)–(14) удобно решать в Фурье-представлении. Из системы уравнений (2), (3) находим Фурье-образ поляризации $\mathcal{F}_1(\mathbf{q}, \omega)$

$$\mathcal{F}_1(\mathbf{q}, \omega) = \chi(\mathbf{q}, \omega) (-3g_1 \mathcal{F}_0 \bar{p} + g_2 \mathcal{F}_0 \bar{\sigma}_{zz}), \quad (15)$$

где

$$\chi(\mathbf{q}, \omega) = \frac{1}{m} \frac{1}{\omega_0^2 + \kappa q^2 + dq_z^2/q^2 - i\Gamma\omega - \omega^2}$$

— обобщенная восприимчивость кристалла на внешнюю силу, затрагивающую его поляризацию, $\omega_0^2 = \sqrt{2\alpha/m}$, $\kappa = \delta/m$, $d = 4\pi/m$, $\Gamma = h/m$.

Подставляя (15) в систему уравнений (12)–(14) и исключая последовательно $\bar{\sigma}_{zz}$ и \bar{p} , с точностью до слагаемых квадратичных по коэффициентам электрострикционной связи g_1, g_2 находим выражение Фурье-образа проекции силы Пича—Келера, действующей на дислокацию

$$\bar{j}_{\perp}(q_z, \omega) = \alpha_D^{-1}(q_z, \omega) \bar{u}(q_z, \omega),$$

где

$$\begin{aligned} \alpha_D^{-1}(q_z, \omega) = -\frac{\mu b^2}{2\pi} \int q_{\perp} q_{\perp} \left\{ \left[\frac{q_{\perp}^2 - \omega^2/c_T^2}{q^2 - \omega^2/c_T^2} + \frac{1}{2(1-\nu)} \frac{q_{\perp}^4}{(q^2 - \omega^2/c_T^2)(q^2 - \omega^2/c_T^2)} - 1 \right] + \right. \\ \left. + \mu g_1 (g_1 + g_2) \frac{1+\nu}{1-\nu} \mathcal{F}_0^2 \chi(\mathbf{q}, \omega) \left[\frac{q_{\perp}^4}{(q^2 - \omega^2/c_T^2)(q^2 - \omega^2/c_T^2)} - 1 \right] - \right. \\ \left. - \mu g_2 (g_1 + g_2) \mathcal{F}_0^2 \chi(\mathbf{q}, \omega) \left[\frac{q_{\perp}^4}{(q^2 - \omega^2/c_T^2)^2} - 1 \right] - \frac{\mu}{1-\nu} g_2 (g_1 + g_2) \mathcal{F}_0^2 \delta^2(\mathbf{q}, \omega) \times \right. \\ \left. \times \left[\frac{q_{\perp}^2 - \omega^2/2c_T^2}{q^2 - \omega^2/c_T^2} \frac{q_{\perp}^4}{(q^2 - \omega^2/c_T^2)(q^2 - \omega^2/c_T^2)} - 1 \right] - \frac{\mu g_2^2 \mathcal{F}_0^2}{1-\nu} \chi(\mathbf{q}, \omega) \times \right. \\ \left. \times \frac{q_{\perp}^4 q_z^2}{(q^2 - \omega^2/c_T^2)^2 (q^2 - \omega^2/c_T^2)} - \frac{\mu g_2^2 \mathcal{F}_0^2}{(1-\nu)^2} \chi(\mathbf{q}, \omega) \frac{q_{\perp}^2 - \omega^2/2c_T^2}{q^2 - \omega^2/c_T^2} \times \right. \\ \left. \times \frac{q_{\perp}^4 q_z^2}{(q^2 - \omega^2/c_T^2)^2 (q^2 - \omega^2/c_T^2)} - \frac{\mu g_1 g_2}{1-\nu} \frac{1+\nu}{1-\nu} \mathcal{F}_0^2 \chi(\mathbf{q}, \omega) \frac{q_{\perp}^4 q_z^2}{(q^2 - \omega^2/c_T^2)(q^2 - \omega^2/c_T^2)^2} - \right. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& - \frac{2\mu}{1-\nu} \frac{1+\nu}{1-\nu} g_1 (2g_1 + g_2) \mathcal{F}_0^2 \chi(\mathbf{q}, \omega) \left[\frac{q_{\perp}^4 (q^2 - A\omega^2/c_i^2)}{(q^2 - \omega^2/c_i^2)(q^2 - \omega^2/c_i^2)^2} - 1 \right] + \\
& + \frac{2\mu}{1-\nu} g_2 (2g_1 + g_2) \mathcal{F}_0^2 \chi(\mathbf{q}, \omega) \left[\frac{q_{\perp}^4 (q^2 - A\omega^2/c_i^2)}{(q^2 - \omega^2/c_i^2)(q^2 - \omega^2/c_i^2)^2} - 1 \right] + \\
& + \frac{2\mu}{(1-\nu)^2} g_2 (2g_1 + g_2) \mathcal{F}_0^2 \chi(\mathbf{q}, \omega) \left[\frac{q_{\perp}^4 (q^2 - A\omega^2/c_i^2)(q_{\perp}^2 - \omega^2/2c_i^2)}{(q^2 - \omega^2/c_i^2)^2 (q^2 - \omega^2/c_i^2)^2} - 1 \right] + \\
& + \mu \mathcal{F}_0^2 \left[- \frac{(1+\nu)(3+\nu)}{(1-\nu)^2} g_1^2 + \frac{5+2\nu}{1-\nu} g_1 g_2 + \frac{(1+\nu)(2-\nu)}{(1-\nu)^2} g_2^2 \right] \chi \\
& \times [\chi(\mathbf{q}, \omega) - \chi(q_x=0, \omega=0)] \quad (16)
\end{aligned}$$

— обратная обобщенная восприимчивость дислокации, описывающая отклик кристалла на внешнюю силу, пространственная зависимость которой характеризуется волновым вектором q_x , временная — частотой ω , $q_{\perp} = \sqrt{q_x^2 + q_y^2}$, $A = (3g_1 + g_2)/2(2g_1 + g_2)$.

В силу значительной громоздкости получающихся выражений явный вид $\alpha_D(q_x, \omega)$ приводить не будем, а сразу перейдем к анализу особенностей колебаний дислокации в сегнетоэлектрическом кристалле.

Приравняв выражение $\alpha_D^{-1}(q_x, \omega)$ к нулю, находим дисперсионное уравнение для изгибных колебаний дислокации. В длинноволновом приближении $q_x \ll q_D$, где q_D — дебаевский волновой вектор, зависимость частоты изгибных колебаний ω от волнового вектора q_x имеет вид

$$\omega = \xi c_i q_x, \quad (17)$$

где $\xi = \xi_0 + \xi_1$,

$$\xi_0 = \frac{\sqrt{2} c_t/c_l}{\sqrt{1 + c_l^2/c_t^2}} = 2 \left(\frac{(1-\nu)(1-2\nu)}{5 - 12\nu + 8\nu^2} \right)^{1/2}$$

— отвечает скорости изгибной волны дислокации в несегнетоэлектрическом кристалле,

$$\xi_1 \sim \chi_0 \mu g^2 \mathcal{F}_0^2 \xi_0$$

— малая добавка к скорости, связанная с электрострикционным взаимодействием упругого поля с поляризацией. Такой же порядок величины, очевидно, имеют поправки к эффективной массе m_e и эффективной жесткости c_e дислокации в сегнетоэлектрическом кристалле

$$\Delta m_e/m_e \sim \Delta c_e/c_e \sim \chi_0 \mu g^2 \mathcal{F}_0^2 \sim 0.1 \div 1.0.$$

Вклад в затухание γ дислокационных колебаний, связанный с рассеянием энергии при колебаниях поляризации, сопутствующих колебаниям дислокации,

$$\begin{aligned}
\gamma = & \left[\frac{(1+\nu)(3+\nu)g_1^2 - (1-\nu)(5+2\nu)g_1g_2}{5 - 12\nu + 8\nu^2} - \frac{(1+\nu)(1-2\nu)g_2^2}{5 - 12\nu + 8\nu^2} \right] \times \\
& \times \frac{4c_l^2 \Gamma \mu \mathcal{F}_0^2}{m \omega_0^2 x^2} \frac{\omega_0^4 + 2d\omega_0^2 + dxq_D^2}{(\omega_0^2 + d)(\omega_0^2 + xq_D^2)} \left(\ln \frac{q_D^2}{q_x^2} \right)^{-1},
\end{aligned}$$

учитывая, что $x \sim c_l^2 \sim 10^7 \text{ м}^2/\text{с}^2$, $\Gamma \sim 10^{13} \text{ с}^{-1}$, сравним с известными фоновыми механизмами рассеяния энергии дислокации [6]. Учитывая, что в рамках теории Ландау от температуры зависит лишь коэффициент $\alpha = \alpha_0(T - T_c)$, нетрудно убедиться, что величина γ практически не зависит от близости к температуре фазового перехода T_c , так же как и поправки к собственной частоте, эффективной массе m_e , эффективной жесткости c_e дислокации. Значительных температурных аномалий $\xi_1 \sim (T - T_c)^{-1}$, $\gamma \sim (T - T_c)^{-1}$ следует ожидать в сегнетоэлектриках, обладающих пьезоэлектрическими свойствами в парафазе, поскольку связь упругих полей и поляризации будет тогда осуществляться через независимый от темпе-

ратуры пьезоэлектрический коэффициент b в отличие от нашего случая, где $b \sim g^2 \mathcal{P}_0$. Однако полученные здесь формулы, строго говоря, неприменимы для этого случая, поскольку влияние поляризации на колебания дислокации уже нельзя рассматривать как малое возмущение, и систему уравнений (2), (3), (12)–(14) нужно решать точно.

Помимо этой ветви изгибных колебаний дислокации существует еще одно решение дисперсионного уравнения $\alpha_D^{-1}(q_x, \omega) = 0$, описывающее локальные колебания дислокации, характеризующееся тем, что частота ω отлична от нуля при $q_x = 0$. По аналогии с колебаниями сложных кристаллических решеток первую ветвь колебаний можно назвать «квазиакустической», а вторую ветвь — «квазиоптической». Соответствующее решение запишем для случая однородных колебаний дислокации ($q_x = 0$)

$$\omega^2 = \omega_0^2 \left(1 - \frac{\chi}{c_i^2} e^{-\frac{A}{B} \omega_0^2} \right), \quad (18)$$

где

$$A = \frac{1}{2c_i^2} \left(\ln \frac{c_i^2 q_D^2}{\omega_0^2} + \frac{1-2\nu}{2(1-\nu)} \ln \frac{c_i^2 q_D^2}{\omega_0^2} \right),$$

$$B = \frac{\mu \mathcal{P}_0^2}{(1-\nu)^2 (1-2\nu) m \chi} [(7-12\nu-7\nu^2+8\nu^3)(1-2\nu) g_1^2 - (5-17\nu+42\nu^2-52\nu^3+24\nu^4) g_1 g_2 - (2-3\nu+33\nu^2-42\nu^3+8\nu^4) g_2^2].$$

Для существования этого решения необходимо чтобы константа B была положительной.

Принимая во внимание формулы (17), (18), нетрудно получить выражения для обобщенных восприимчивостей, описывающих отклик дислокаций на низкочастотное и высокочастотное длинноволновое внешнее возмущение.

В первом случае, разлагая выражение для $\alpha_D^{-1}(q_x, \omega)$ в ряд по ω^2 вблизи собственной частоты $\omega(q_x)$, задаваемой формулой (17), находим

$$\alpha_D^{(l)}(q_x, \omega) = \frac{C}{\omega^2(q_x) - \omega^2 - i\gamma\omega},$$

где

$$C = \frac{\pi}{\rho b^2} \left(\frac{c_i^4/c_i^4}{1+c_i^4/c_i^4} \ln \frac{q_D^2}{q_x^2} \right)^{-1},$$

γ — полное затухание дислокационных колебаний.

В случае высокочастотного возмущения аналогичным способом находим

$$\alpha_D^{(h)}(q_x, \omega) = \frac{4\pi}{\rho b^2} e^{-\frac{A}{B} \omega_0^2} \frac{1}{\omega^2(q_x) - \omega^2 - i\gamma\omega}.$$

Здесь $\omega^2(q_x)$ определяется по формуле (18), γ — полное затухание в этой ветви.

3. Распределение поляризации и электрических полей вокруг дислокации

Развитый в настоящей работе подход позволяет исследовать распределение поляризации и электрических полей вокруг колеблющейся дислокации. Задача о распределении электрических полей вокруг дислокации в пьезоэлектрике в статическом случае решалась в работе [7]. В [8, 9] исследовано распределение намагниченности и магнитных полей в ферромагнетике с дислокацией также в статическом случае.

Предположим, что дислокация совершает колебания по закону

$$u = u e^{ikz - i\omega t}.$$

Сопровождающие колебания дислокации, колебания упругих, электрических полей и поляризации определяются из системы уравнений (12)–(15). Интересуясь в дальнейшем только зависящими от времени компонентами указанных полей для Фурье-образов величин p и σ_{xx} , имеем

$$\begin{aligned} \bar{p} &= -\frac{8\pi^2}{3} \mu b \frac{1+\nu}{1-\nu} u_0 \frac{q_x q_y \delta(\omega-\nu) \delta(q_x-k)}{q^2 - \omega^2/c_i^2}, \\ \bar{\sigma}_{xx} &= 8\pi^2 \mu b u_0 \frac{q_x q_y \delta(\omega-\nu) \delta(q_x-k)}{q^2 - \omega^2/c_i^2}. \end{aligned} \quad (19)$$

Подставляя (19) в уравнения (12)–(15) после несложных преобразований для Фурье-образов поляризации \mathcal{P}_z и напряженности электрического поля E получаем следующие выражения:

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_z(q, \omega) &= 8\pi^2 b \epsilon_0 \chi(q, \omega) \left(g_1 \frac{1+\nu}{1-\nu} \frac{1}{q^2 - \omega^2/c_i^2} + g_2 \frac{1}{q^2 - \omega^2/c_i^2} \right), \\ \bar{E} &= -\frac{4\pi q q_x \epsilon_0 \mathcal{P}_z(q, \omega)}{q^2}. \end{aligned} \quad (20)$$

Совершая Фурье-обращение формул (20), находим распределение поляризации и электрических полей вокруг колеблющейся дислокации. Выражение для \mathcal{P} имеет вид

$$\mathcal{P}(r, t) = \frac{\mu b}{\pi} \mathcal{P}_0 u_0 \chi_0 \left(g_1 \frac{1+\nu}{1-\nu} \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} I_1 + g_2 \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} I_2 \right) e^{ikx - i\nu t}, \quad (21)$$

где

$$\begin{aligned} I_{1,2} &= \frac{\pi}{2} \frac{v^2/c_i^2, t}{dk^2/\omega_0^2 + v^2/c_i^2, t} Y_0(\rho \sqrt{v^2/c_i^2, t - k^2}) + \left(1 + \frac{d \chi k^2}{\omega_0^2} \right) K_0\left(\frac{\rho \omega_0}{\sqrt{\chi}}\right) - \\ &\quad - \frac{dk^2/\omega_0^2}{dk^2/\omega_0^2 + v^2/c_i^2, t} K_0(\rho k \sqrt{1 + d/\omega_0^2}). \end{aligned}$$

Здесь $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, Y_0 — функция Неймана, K_0 — функция Макдональда. При записи этих формул предполагалось выполнение условия $k^2 > v^2/c_i^2$. В этом случае, согласно (21), при удалении от линии дислокации поляризация убывает по степенному закону $\mathcal{P} \sim \rho^{-3/2}$. Если же $k^2 < v^2/c_i^2$, то в выражениях для I_1 и I_2 нужно сделать замену

$$Y_0(\rho \sqrt{v^2/c_i^2, t - k^2}) \rightarrow -\frac{2}{\pi} K_0(\rho \sqrt{k^2 - v^2/c_i^2, t}).$$

Спадание \mathcal{P} в этом случае будет происходить по экспоненциальному закону на расстояниях $l \sim (\sqrt{k^2 - v^2/c_i^2})^{-1}$.

Электрические поля, связанные с дислокацией в нашем случае $\mathcal{P}_0 \parallel \tau$, имеют чисто динамическую природу. В качестве иллюстрации распределения электрического поля вокруг дислокации приведем выражение для компоненты вектора напряженности электрического поля E_x ($k^2 > v^2/c_i^2$).

$$E_x(r, t) = 4\mu b \epsilon_0 u_0 \chi_0 k^2 \left(g_1 \frac{1+\nu}{1-\nu} \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \Phi_1 + g_2 \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \Phi_2 \right) e^{ikx - i\nu t},$$

где

$$\begin{aligned} \Phi_{1,2} &= \frac{1}{\omega_0^2 \chi} K_0\left(\frac{\rho \omega_0}{\sqrt{\chi}}\right) - \frac{\pi}{2} \frac{1}{dk^2/\omega_0^2 + v^2/c_i^2, t} Y_0(\rho \sqrt{v^2/c_i^2, t - k^2}) - \\ &\quad - \frac{1}{dk^2/\omega_0^2 + v^2/c_i^2, t} K_0(\rho k \sqrt{1 + d/\omega_0^2}). \end{aligned}$$

Полученные в настоящей работе результаты могут быть использованы для исследования затухания и рассеяния ультразвука и электромагнитных волн в сегнетоэлектрическом кристалле с дислокациями, для расчета вклада дислокаций в диэлектрическую проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь, в пьезомодули кристаллов и т. д.

Список литературы

- [1] Ninomiya T. // J. Phys. Soc. Jap. 1968. V. 25. N 3. P. 830—840.
[2] Вахс В. Г. Введение в микроскопическую теорию сегнетоэлектриков. М.: Наука, 1973. 327 с.
[3] Gross H. // Phys. St. Sol. 1964. V 5. N 2. P. 329—342.
[4] Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория упругости. М.: Наука, 1987. 248 с.
[5] Де Вит Р. Континуальная теория дисклинаций. М.: Мир. 1977. 208 с.
[6] Альшиц В. И., Инденбом В. Л. // УФН. 1975. Т. 115. № 1. С. 3—39.
[7] Косевич А. М., Пастур Л. А., Фельдман Э. П. // Кристаллография. 1967. Т. 12. № 5. С. 916—923.
[8] Косевич А. М., Фельдман Э. П. // ФТТ. 1967. Т. 9. № 12. С. 3415—3421.
[9] Гамк В. В., Фельдман Э. П. // ФНТ. 1976. Т. 2. № 1. С. 30—36.

Воронежский политехнический институт
Воронеж

Поступило в Редакцию
30 мая 1989 г.
В окончательной редакции
20 октября 1989 г.